

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чуевой Татьяны Равильевны «Разработка "толстых" аморфных микропроводов в системе $Fe_{75}Si_{10}B_{15}$ – $Co_{75}Si_{10}B_{15}$ – $Ni_{75}Si_{10}B_{15}$ », представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.01 «Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов».

которых являются и разрабатываемые в последнее годы аморфные микропровода. Благодаря уникальному сочетанию физических и механических свойств микропровода могут использоваться в качестве высокочувствительных сенсоров поля и всевозможных датчиков перемещений и напряжений. Расширить область их применения возможно, увеличив толщину производимых микропроводов, и одним из путей решения этой задачи является поиск новых составов с высокой стеклообразующей способностью (СОС). Так как основой для практически важных аморфных сплавов являются недорогие ферромагнитные 3d-металлы (железо, никель, кобальт), то поставленная в работе цель определения легкоаморфизующихся составов в системе $Fe_{75}Si_{10}B_{15}$ – $Co_{75}Si_{10}B_{15}$ – $Ni_{75}Si_{10}B_{15}$ и получения "толстых" микропроводов является актуальной научной задачей. Немаловажно, что в работе решались и практические задачи, связанные с поиском областей применения разрабатываемых аморфных микропроводов.

поиску составов с высокой стеклообразующей способностью. Сопоставление достоинств и недостатков различных методов получения аморфного состояния позволило автору обосновать использование метода Улитовского-Тейлора для получения "толстых" аморфных микропроводов. Для исследования образцов микропроводов использовались термический и рентгеноструктурный анализ, световая и электронная микроскопия, проводились измерения механических и магнитных свойств, что позволило получить всестороннюю информацию о структуре и важных для применения свойствах объектов.

типа кристаллизации большого числа сплавов и установлено, что наиболее высокая СОС микропроводов наблюдается при двустадийной кристаллизации аморфной фазы, которая изучена детально в следующей главе. В ходе этого исследования сделана попытка подвести научную базу под обнаруженную корреляцию между типом кристаллизации и высокой СОС сплавов и выдвинуто предположение о расслоении расплава и формировании двух близких по составу аморфных фаз. Но из текста автореферата не ясно, были ли получены какие-либо подтверждения этого расслоения дифракционными методами – просвечивающей электронной микроскопией или рентгеноструктурным анализом, хотя возможностей последнего может оказаться недостаточно. Тем не менее этот вопрос представляет большой научный интерес, так как, хотя эффект расслоения аморфной фазы иногда упоминается в литературе, его систематических исследований, насколько мне известно, не проводилось.

Эффект зависимости магнитных свойств микропроводов от приложенных внешних напряжений, что создает предпосылки для применения микропроводов в различных

2

ответственных конструкциях. Замечательно, что в работе представлены принципиальные схемы подобных устройств и делается несколько любопытных предложений по созданию изделий, содержащих этот перспективный материал.

Помимо упомянутого выше недоказанного эффекта расслоения аморфной фазы, к недостаткам работы можно отнести частое упоминание термина "фазы-стеклообразователи" без определения, какие фазы следует к ним относить, что усложняет понимание рассуждений о механизме кристаллизации микропроводов с высокой СОС.

хорошее впечатление ясностью и лаконичностью изложения и, несомненно, представляет интерес как с научной, так и с практической точки зрения. Результаты работы прошли апробацию и докладывались на нескольких российских и международных научных конференциях. Данная диссертационная работа удовлетворяет всем требованиям ВАК предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – Чуева Татьяна Равильевна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.01 – "Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов".

материалов НИТУ МИСиС, к.ф.-м.н.

Chay



10

Подпись
СОМОЧА
закрепляю

Зам. начальника

отдела кадров МИСиС

«VI» IV 2014 г.